

Étude de transistors pnp sur SOI: Développement de transistors pnp Si/SiGeC sur SOI mince en vue de leur intégration dans une technologie BiCMOS complémentaire PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Récemment, les transistors bipolaires de type pnp sur silicium, intrinsèquement moins performants que les transistors npn, ont connu un regain d'intérêt avec le développement des technologies BiCMOS complémentaires. Elles associent les transistors MOS avec les transistors bipolaires de type npn et pnp, permettant d'atteindre des performances supérieures aux technologies BiCMOS classiques qui utilisent uniquement des transistors bipolaires de type npn. De plus, en combinant cette technologie avec un substrat SOI mince au lieu d'un substrat massif, les caractéristiques des transistors MOS et des composants passifs s'en trouvent améliorées. Le travail présenté ici a pour objet la mise au point et l'étude de transistors bipolaires à hétérojonctions Si/SiGeC de type pnp sur SOI mince performants, en vue de leur intégration dans une technologie BiCMOS SiGe complémentaire sur SOI mince.

Scopri Étude de transistors pnp sur SOI: Développement de transistors pnp Si/SiGeC sur SOI mince en vue de leur intégration dans une technologie . un regain d'intérêt avec le développement des technologies BiCMOS complémentaires.

Du transistor bipolaire à homojonction au transistor à hétérojonction SiGe 13 ... Chapitre III: Etude et modélisation du bruit basse fréquence des .. BiCMOS comportant sur une même puce des TBH Si/SiGe et des transistors MOS est . HBT SiGe pnp . SiGeHBTverticalà couche mince(compatible CMOS) SOI.

Développement de transistors pnp Si/SiGeC sur SOI mince en vue de leur intégration dans une technologie BiCMOS complémentaire .. Outils Et Methodologie D Etude Des Systemes Electriques Polyphases - Semail-e - ISBN: book. € 59,00.

24 oct. 2017 . Circuit qui utilise des composants comme les transistors ou les circuits .. Technologie d'affichage qui double le nombre de lignes d'un écran plasma. .. Centre National d'Etudes des Télécommunications .. Norme pour le transfert des photos numériques en vue de leur ... Table d'évènement (DVB-SI).

transistors bipolaires à hétérojonction Si/SiGe/Si dans le domaine . devront faire l'objet d'études complémentaires par la suite. .. Son intégration dans des technologies BiCMOS fut étudiée mais ne fut jamais mise en œuvre. .. Les transistors PNP, qui ont pourtant été étudiés dans la littérature, [62], ne marquent en.

. transistors pnp sur SOI: Développement de transistors pnp Si/SiGeC sur SOI mince en vue de leur intégration dans une technologie BiCMOS complémentaire.

4 juin 2010 . type pnp sur substrats SOI minces . accepté de participer à mon jury de thèse et pour leur travail de relecture du manuscrit. . la finalité du développement. . Chapitre I : Le transistor bipolaire de type pnp à hétérojonctions Si/SiGeC..15 ... I.D.1.2) Technologie BiCMOS Si/SiGe complémentaire sur SOI .

Étude de transistors pnp sur SOI: Développement de transistors pnp Si/SiGeC sur SOI mince en vue de leur intégration dans une technologie BiCMOS.

Développement et étude de transistors bipolaires Si/SiGe sur SOI mince. DUTARTRE et les ... Intégration d'un TBH Si/SiGe sur substrat SOI mince ...47. II.1. ... V. Développement d'une technologie BiCMOS sur SOI mince141. V.1. ... sont des électrons, il existe aussi un type PNP dont les porteurs minoritaires sont des.

à Christian et Nicolas pour leur aide concernant les mesures, Nicolas, je te souhaite ... Développement et étude de TBH Si/SiGe:C pour les technologies BiCMOS .. premier TBH Si/SiGe de type PNP a été démontrée en 1990 [Haramé90]. ... transistors bipolaires est l'intégration de l'alliage silicium-germanium Si1-xGex.

Étude de transistors pnp sur SOI: Développement de transistors pnp Si/SiGeC sur SOI mince en vue de leur intégration dans une technologie BiCMOS . soi-mince-en-vue-de-leur-integration-dans-une-technologie-bicmos-complementaire.pdf.

Développement de transistors pnp Si/SiGeC sur SOI mince en vue de leur intégration dans une technologie BiCMOS complémentaire . 284. Outils Et Methodologie D Etude Des Systemes Electriques Polyphases - Semail-e - ISBN: book.

D) Développement des matériaux et problèmes de fabrication II. . D.4) Transistor pnp Si/SiGeC sur SOI mince après résolution des problèmes de . IV : Etude expérimentale et optimisation du transistor pnp Si/SiGeC sur SOI mince IV. .. leur intégration dans la technologie BiCMOS complémentaire sur SOI mince et leur.

20 déc. 2007 . L'étude des transistors bipolaires `a hétérojonction n'est possible que .. I Le transistor bipolaire `a hétérojonction Si / SiGeC ... II.3.4.b Schéma d'intégration BiCMOS C'est dans le cadre du développement de technologies BiCMOS .. les deux configurations possibles NPN ou PNP, appelées succes-.

Étude de transistors pnp sur SOI: Développement de transistors pnp Si/SiGeC sur SOI mince en vue de leur intégration dans une technologie BiCMOS complémentaire (French Edition) [Julien Duvernay, Alain Chantre] on Amazon.com.

8 mai 2013 . Sud, il travaille en particulier sur l'étude du comportement de usagers des NTIC. . travaillent dans un même PC et affichent alternativement leur image. ... BDK (Board Development Kit) Kit de développement avec circuit imprimé. . à faible impédance de sortie et à faible bruit et des transistors CMOS à.

